

عنوان مقاله:

ارزیابی اثر فاصله بین اتمی در رسانش الکترونی نانوسیم های سیلیکونی

محل انتشار:

کنگره ملی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا توسعه ملی (سال: 1396)

تعداد صفحات اصل مقاله: 5

نویسندگان:

سیدمحمد اعظمی - دانشگاه یاسوج گروه شیمی

سیده زینب موسوی محمره - دانشگاه یاسوج گروه شیمی

خلاصه مقاله:

محاسبات Abintio در سطح محاسباتی HF و با مجموعه پایه 31G-6* برای ارزیابی فاصله بین اتمی در رسانش الکترونی نانوسیم های سیلیکونی به کار گرفته شده است. نانوساختارهای سیلیکونی با فاصله های بین اتمی متفاوت در سیستم های یک بعدی مورد بررسی قرار گرفتند. این نانوساختارها دارای تقارن های متفاوتی هستند و بسته به نوع تقارن، فواصل بین اتمی نیز متفاوت خواهند بود. هدف از این مطالعه، بدست آوردن فاصله ی مناسب، بین اتم های سیلیکون است که در آن فاصله بیشترین رسانش سیستم ملاحظه می شود.

کلمات کلیدی:

رسانش الکترونی، نانوساختار، سیلیکون، HLG

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/718289>

